

卒業論文
リングイメージ型検出器 (RICH)
の性能評価

戸田 匡哉 徳田 恵

2021 年 5 月 12 日

概要

我々は J-PARC ハドロン実験施設の高運動量ビームラインにおいてチャームバリオン分光実験 (J-PARC-E50) を計画している。実験では運動量 $20 \text{ GeV}/c$ のビーム粒子と標的との反応で生成する $2\sim 16 \text{ GeV}/c$ の高運動量散乱粒子の識別を行う必要がある。この広い運動量領域において粒子識別を行うためにリングイメージチェレンコフ検出器を開発している。

粒子識別性能に関わる角度分解能のうち、収差等の内訳を調べるため、テスト機を用いて SPring-8 の LEPS ビームラインにおいてテスト実験を行った。光センサーとして MPPC アレイを使用し、同時に MPPC の暗電流による角度分解能への影響や電圧依存性を調査した。MPPC アレイは 8×8 の 64 セグメントで、各セグメントの大きさが $3\text{mm}\times 3\text{mm}$ のものを用いた。実験では空気を輻射体とし、 $0.95 \text{ GeV}/c$ の電子・陽電子からのチェレンコフ光を球面鏡によって MPPC アレイ上に結像させた。また、MPPC の動作電圧を 0.5V ずつ $54.0\text{V}\sim 57.5\text{V}$ の間で変化させ、取得した TDC データからリングイメージを測定した。

得られたリングイメージからリング中心を決定しイベント毎にチェレンコフ角を計算、角度分解能の hit 数依存性から角度分解能をセグメントサイズによる位置分解能 $\Delta\theta_{seg}$ と、収差などによる分解能 $\Delta\theta_{other}$ に分けた。セグメントサイズによる位置分解能は用いた MPPC の 1 セグメントの大きさと球面鏡の焦点距離から計算によって求められ、 $\Delta\theta_{seg} = 2.80 \text{ mrad}$ となる。収差などによる分解能は、角度分解能の hit 数依存性のグラフからフィッティングから見積もり、 $\Delta\theta_{other} = 3.88 \pm 0.02 \text{ mrad}$ となった。ここから焦点面と検出面の位置のずれや、入射粒子の角度分解能、色収差などに細分し、残ったものを暗電流の影響とした。

また各動作電圧でのイベントごとの hit 数から、hit 数の電圧依存性とシミュレーションによる再現を行った。

目次

第 1 章	序論	2
1.1	チャームバリオン分光実験 (E50 実験)	2
1.2	測定原理	3
1.3	研究目的	4
1.3.1	先行研究による RICH 検出器実機の構成と要求性能	4
1.3.2	Multi Pixel Photon Counter	4
第 2 章	実験のセットアップ	5
第 3 章	解析	6
3.1	TDC	6
3.2	hit 数	6
3.3	hit pattern の確認	7
3.4	リングイメージの中心	8
3.4.1	決定方法 1	9
3.4.2	決定方法 2	9
3.5	リング半径	10
3.6	チェレンコフ角・角度分解能	11
第 4 章	結果	12
4.1	hit 数	12
4.2	リング半径・チェレンコフ角	13
4.2.1	リング半径・チェレンコフ角の絶対値のズレ	13
4.2.2	リング半径・チェレンコフ角の電圧依存性	14
4.3	角度分解能	14
4.3.1	1 p.e. あたりの分解能	15
4.3.2	角度分解能の内訳	16
4.3.3	収差などによる角度分解能	16
4.3.4	暗電流の角度分解能への寄与	16
第 5 章	まとめ	18

第 1 章

序論

1.1 チャームバリオン分光実験 (E50 実験)

現在、J-PARC ではダイクォーク相関の解明を目的としたチャームバリオン分光実験、E50 実験が計画されている。この実験ではビーム運動量 20 GeV/c の π^- を液体水素標的に当て、次のチャームバリオン Y_c^{*-} 生成反応を起こす。

$$\pi^- + p \rightarrow Y_c^{*-} + D^{*-} \quad (1.1)$$

この時に生じる D^{*-} の崩壊モード

$$D^{*-} \rightarrow \bar{D}^0 \pi^- \rightarrow K^+ \pi^- \pi^- \quad (1.2)$$

ここから生じる K^+, π^-, π^- の運動量から D^{*-} を再構成し、Missing Mass 法によって Y_c^{*-} を測定する。

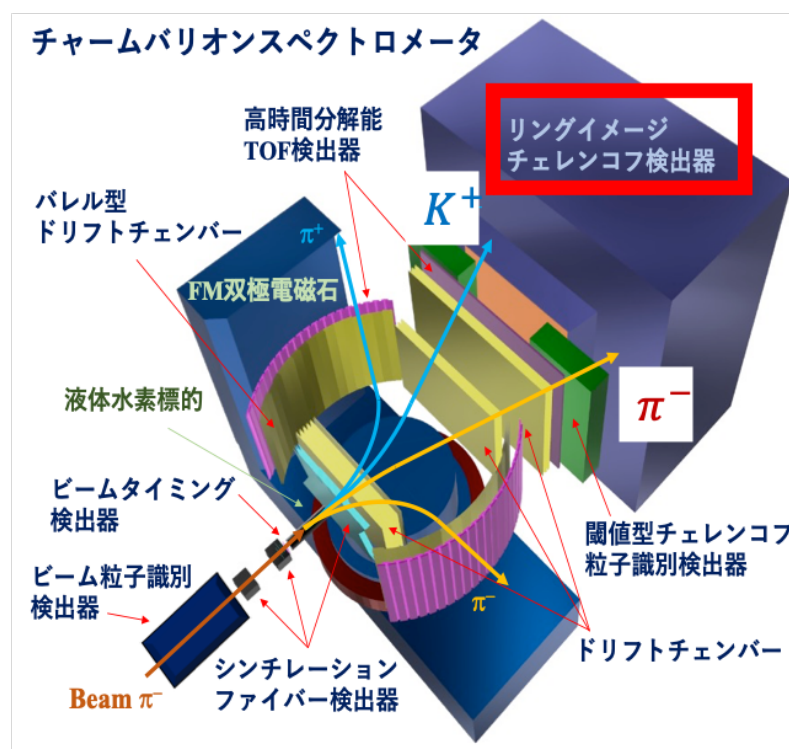


図 1.1 E50 実験のセットアップ。図後方のものがリングイメージチェレンコフ (RICH) 検出器

D^{*-} の一連の崩壊から生じる K^+, π^- を 2~16 GeV/c の広い運動量領域で粒子識別を行う必要がある。そこで用いられる PID 検出器が図 1.1 後方のリングイメージチェレンコフ検出器である。

1.2 測定原理

荷電粒子が物質中を通過する際にその速度が物質中の光速より早い場合、すなわち次式のような条件を満たす時、円錐状に光が発生する。

$$v > \frac{c}{n} \Leftrightarrow \beta > \frac{1}{n} \quad (1.3)$$

発生するチェレンコフ光と荷電粒子の進行方向がなす角をチェレンコフ角 θ_c と呼び、チェレンコフ角と荷電粒子の速度、物質の屈折率の関係は次式で表される。

$$\cos \theta_c = \frac{1}{n\beta} \quad (1.4)$$

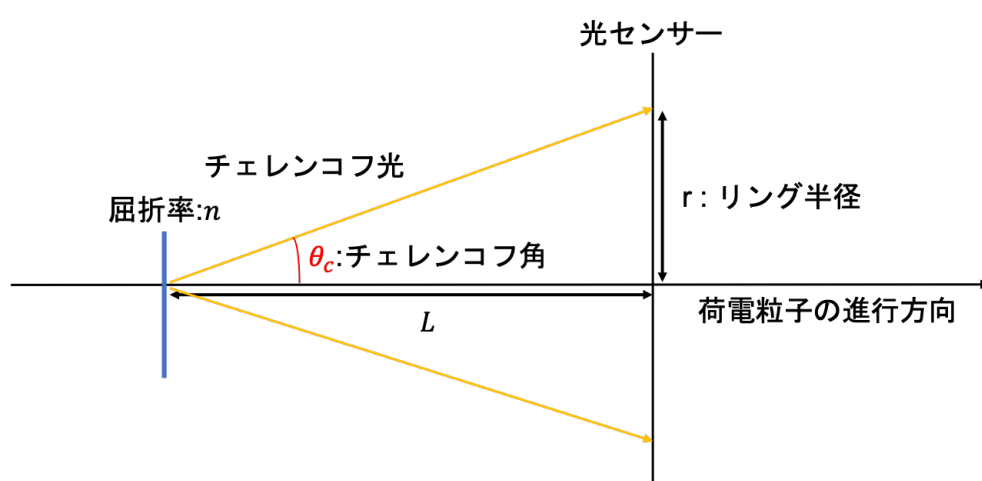


図 1.2 チェレンコフ光が発生する様子

リングイメージチェレンコフ検出器では測定したリングイメージの半径と、輻射体から光センサーまでの距離 L を用いて次の式からチェレンコフ角を算出する。

$$\tan \theta_c = \frac{r}{L} \Leftrightarrow \theta_c = \arctan \left(\frac{r}{L} \right) \quad (1.5)$$

このチェレンコフ角を用いて式 (1.4) より、粒子の速度を求めることで粒子識別を行う。

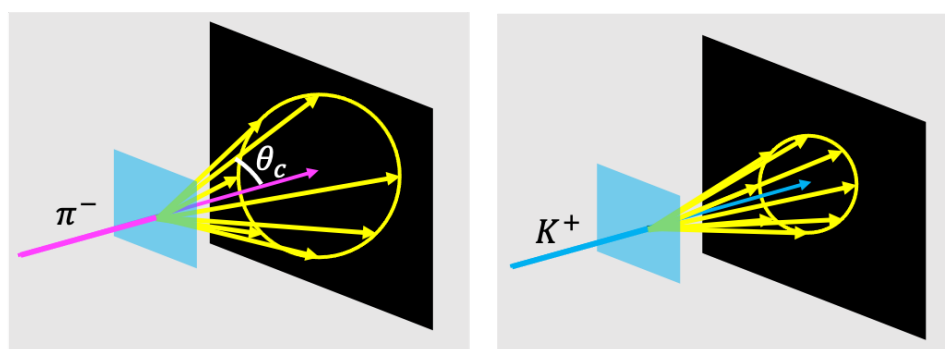


図 1.3 π^- と K^+ によるチェレンコフ光

1.3 研究目的

1.3.1 先行研究による RICH 検出器実機の構成と要求性能

先行研究での実機の構成として、エアロゲル ($n=1.04$) と C_4F_{10} ガス ($n=1.0037$) の2種類の輻射体を用いて、広い運動量領域においてチェレンコフ光を放出させる。このチェレンコフ光を球面鏡で反射させ、光センサー上で収束させることでリングイメージを観測する。

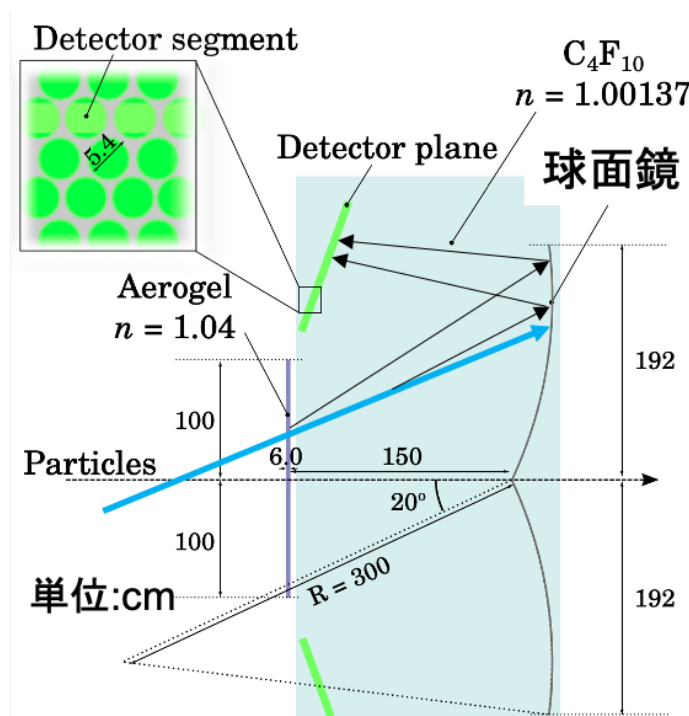


図 1.4 実機のデザイン (先行研究より)

実機の要求性能は次のようになっている。目標とする粒子識別性能 99% に要求される角度分解能は $\Delta\theta_c < 10\text{mrad}$ であり、角度分解能は以下の要素に影響される。

1. セグメントサイズの大きさによる位置分解能
2. 色収差、輻射体の厚さによる分散、検出面での収束等の収差などの影響
3. ビームの角度分解能

このうち、収差などの影響の内訳は詳細にわかっていないため、球面鏡と光センサーとして MPPC を用いた小型のテスト機を用いて収差の内訳について調査を行なった。

1.3.2 Multi Pixel Photon Counter

今回のテスト実験で用いた光センサーである Multi Pixel Photon Counter、MPPC は安価である、磁場に強いといった利点がある。一方で熱電子が増幅され、1 光電子が常にノイズとして出ており、暗電流が大きいという特徴がある。その計数率は 100 300kHz であり RICH 検出器では 1 光電子を捉えるため、その影響についても併せて調査しシミュレーションによる再現を行なった。また電圧によってゲインと検出効率が変化するといった特徴もあり、以降では MPPC の動作電圧 $V_{operation}$ から、信号が出始める電圧 $V_{breakdown} \sim 51V$ を引いた $V_{overvoltage}$ という表記を用いる。

第 2 章

実験のセットアップ

2020 年 12 月に SPring-8 の LEPS ビームラインにて実験を行なった。0.95 GeV/c の電子・陽電子をビームとして用い、空気を輻射体とした。暗箱内にはビーム軸に対してチェレンコフ光が 15° の角度で反射するように球面鏡を配置し、MPPC 上に収束させた。暗箱外側の先端と後部にはトリガーカウンターとして 10mm 角のプラスチックシンチレーターをそれぞれビーム軸上に配置した。

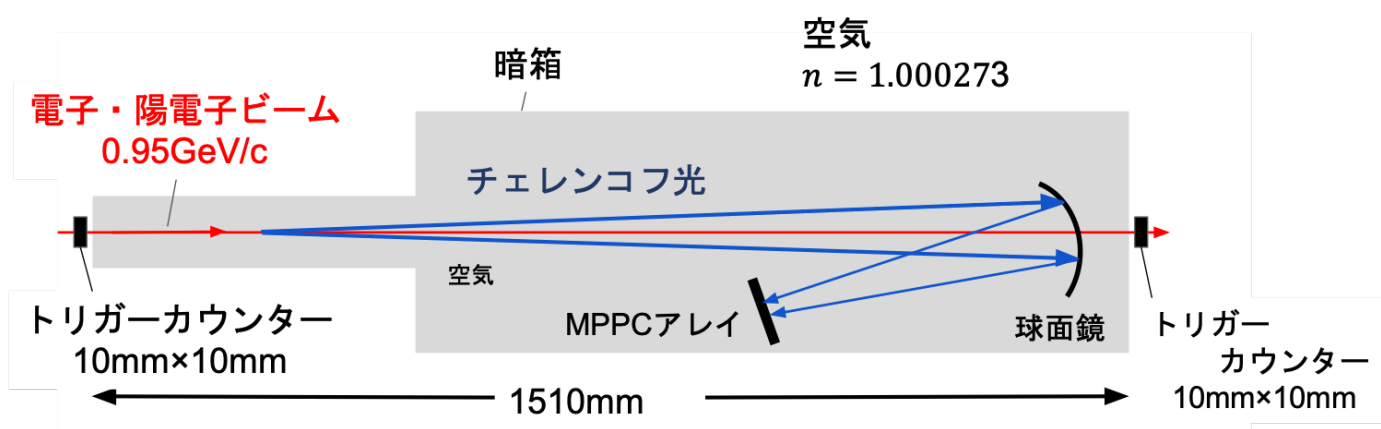
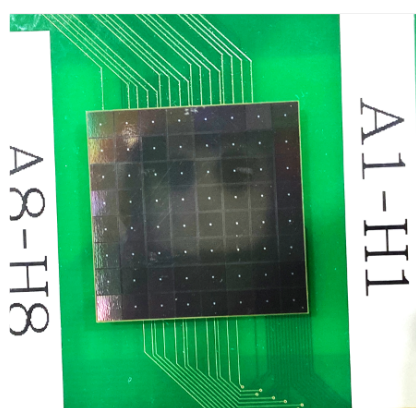
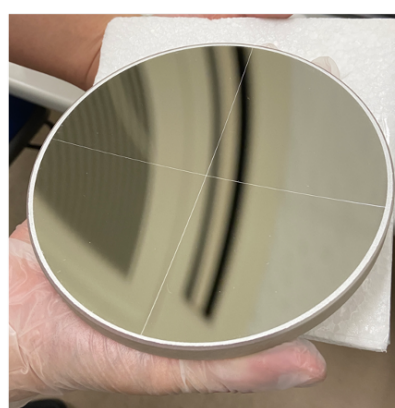


図 2.1 実験のセットアップ

MPPC は 8×8 の 2 次元アレイ、64 セグメントのものを使用し、1 セグメントの大きさは 3.2mm 角である。動作電圧は 54 57.5V まで 0.5V 刻みで測定を行なった。読み出しには NIM-EASIROC module を使用し、TDC 情報を取得した。使用した球面鏡は直径が 150mm、曲率半径は 660mm、焦点距離はその半分の 330mm である。



[1] MPPC



[2] 球面鏡

図 2.2 使用した MPPC と球面鏡

第 3 章

解析

3.1 TDC

TDC を取得するための閾値は動作電圧が最も低い $V_{ov} = 3.0V$ の時の 1p.e. にかけた。取得した TDC のヒストグラムが図 3.1 である。図 3.1 より、今回の TDCcut 幅は 20 と決定した。また、幅は 20 に固定し、cut

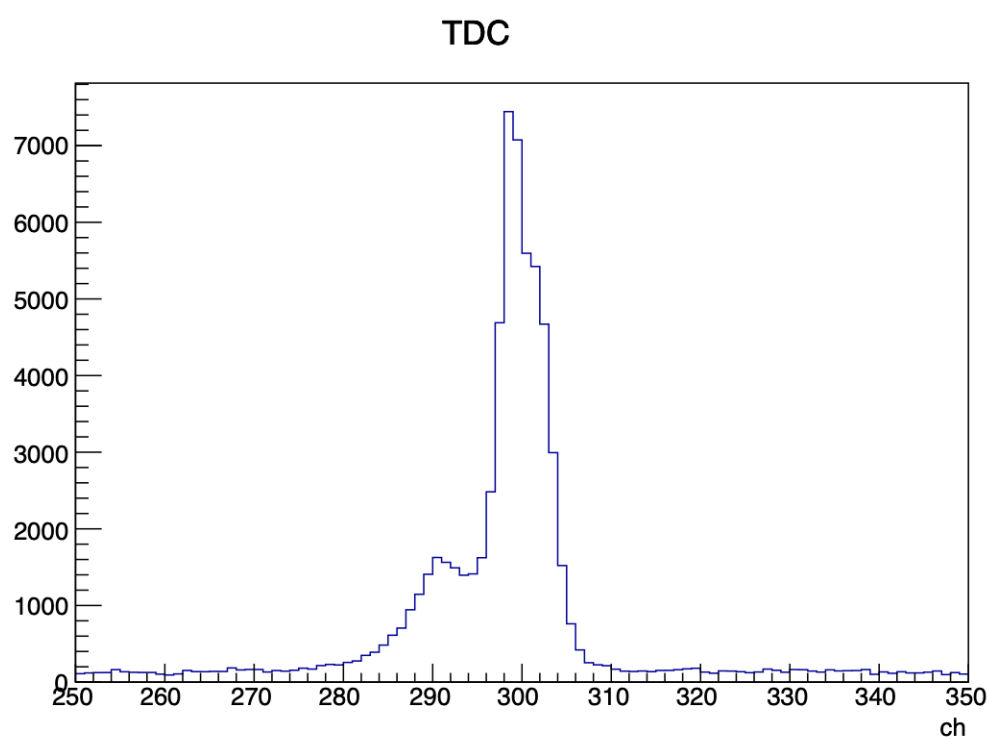


図 3.1 得られた TDC のヒストグラム。全てのチャンネルを足し合わせている。

position は $\frac{signal}{bg}$ 比が最も良くなる場所を scan によって決定した。図 3.2 より、今回の TDCcut position は 287 ~ 307ch に決定した。

3.2 hit 数

先ほど決定した TDCcut を用いて、1 イベントあたりに光子が入ってきたセグメントの数を数え、それを hit 数とした。ただし、今回は TDC で hit の有無のみをみているため、1 セグメントに光子が複数個入っても 1hit として数える。

全イベントで hit 数を出し、そのヒストグラムをガウスフィットすることでピークから各電圧での平均の hit

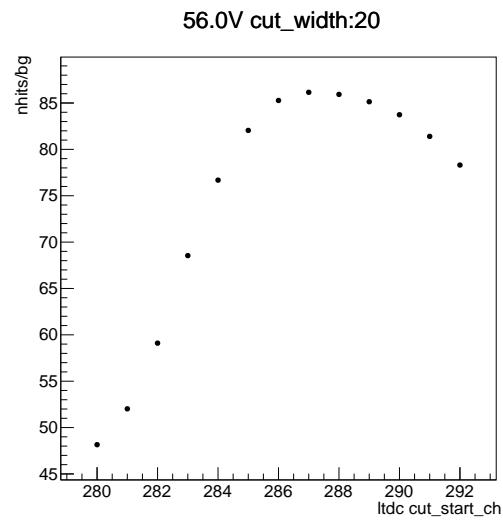


図 3.2 Vov 5V での scan の様子。横軸は cut のスタート位置で cut 幅は 20 で固定している。

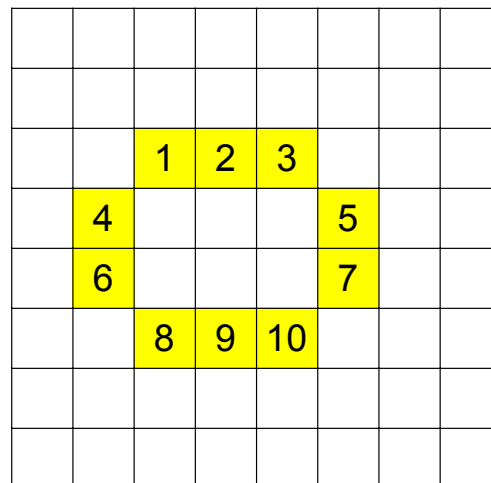


図 3.3 あるイベントで黄色のセグメントに光子が入ってきた場合の図。この場合だと 10hit となる。

数を決定した。また、TDC の cut 範囲をピーク位置 (287 ~ 307ch) からずらした 400 ~ 420ch にしたときの hit 数を暗電流による hit 数とした。

3.3 hit pattern の確認

先ほど求めた hit 数をセグメントごとに全イベント分足し上げることで、hit pattern を確認したところ、図 3.5 のようにチェレンコフリングを確認することができた。

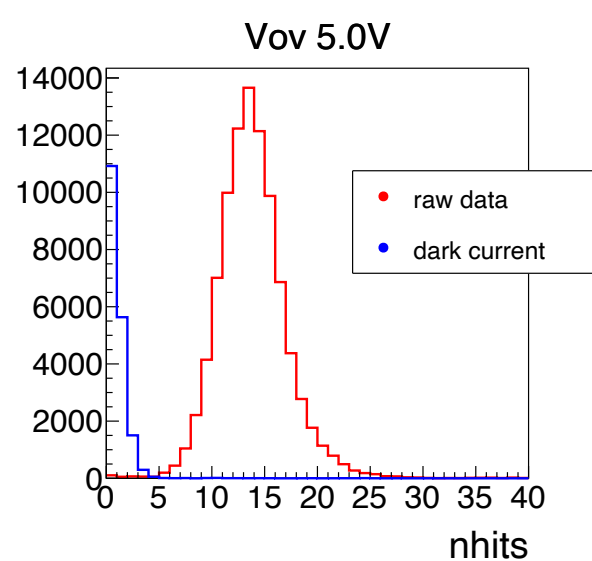


図 3.4 Vov5 V の nhits

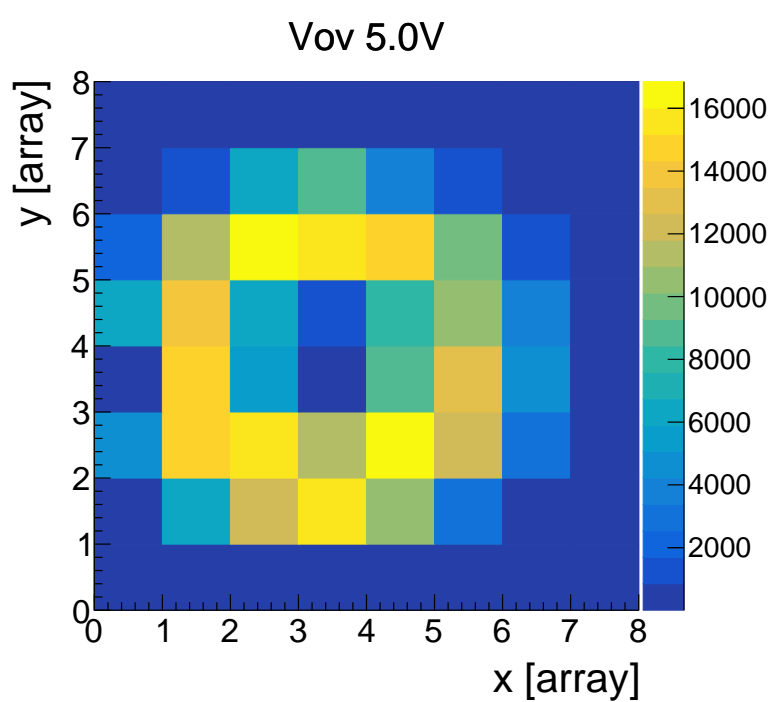


図 3.5 Vov5 V の hitpattern

3.4 リングイメージの中心

hit pattern を見るとわかるように、今回の実験ではアレイの中心とリングの中心がズレていることがわかった。そこで、リング中心の決定を最初におこなった。

3.4.1 決定方法 1

まずアレイを 1 列ずつ取り出し、円周上に来るところで 2 つのピークが見えるのでそのピーク間の距離を求めた。円の方程式より、図 3.6 の x_1, x_2, y_0 には次のような関係が成り立つ。

$$x_2 - x_1 = 2\sqrt{p_0^2 - (y_0 - p_1)^2} \quad (3.1)$$

求められたピーク間の距離を式 3.1 でフィッティングすることで円の中心を求めた。この方法では、リングの

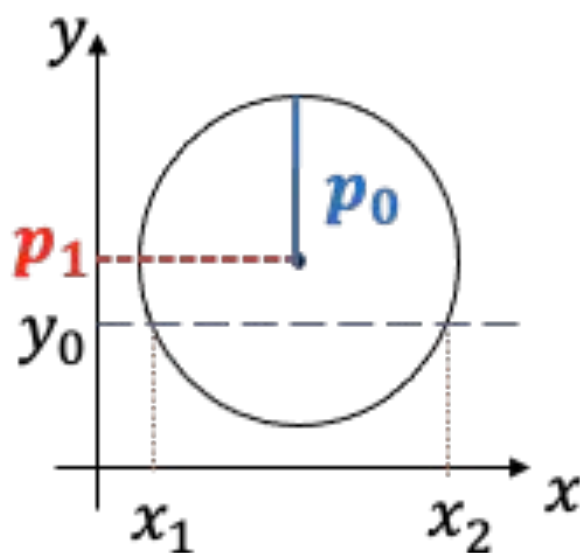


図 3.6 y を固定した時の図。 x_1, x_2 の 2 点のピークが見えるので、ピークの間隔から $x_2 - x_1$ を求める。

中心はアレイのマス目を単位として (3.3, 4.1) と決定された。

3.4.2 決定方法 2

ここにはリング中心の求め方の二つ目を書く

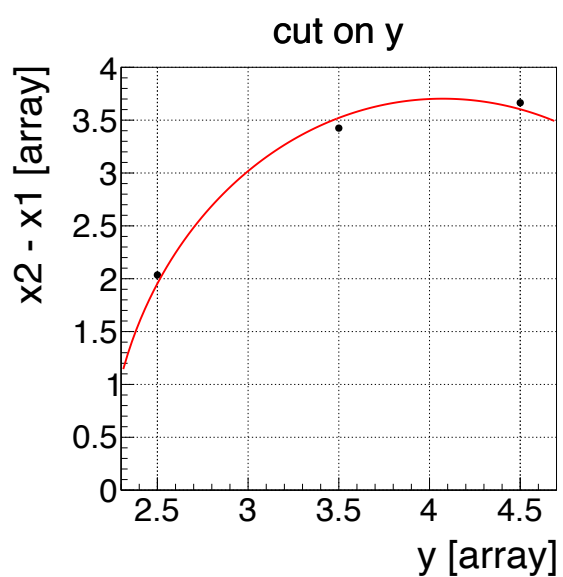


図 3.7 ある y で切った時の x_1, x_2 の差

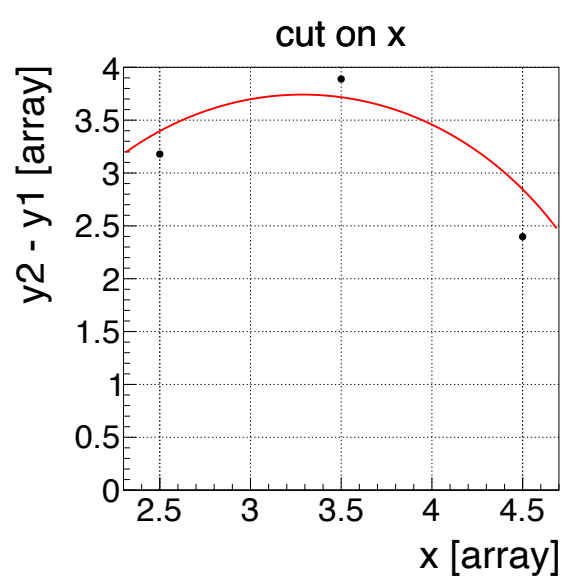


図 3.8 ある x で切った時の y_1, y_2 の差

3.5 リング半径

イベントごとに、リング中心から hit したセグメントまでの距離を平均し、それを全イベントで積み上げてヒストグラムを描いた。そのヒストグラムをガウスフィットし、mean をその電圧での平均半径とした。

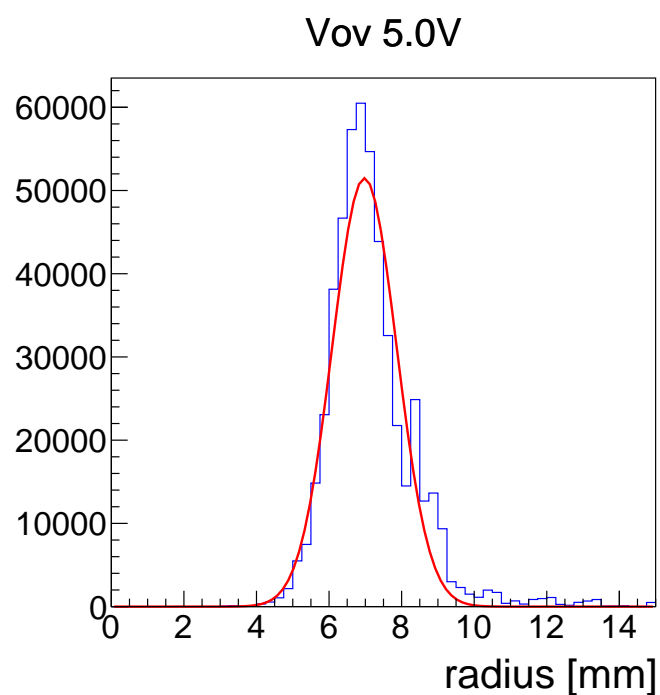


図 3.9 イベントごとに計算したリング半径を全イベント分で積み上げたヒストグラム

3.6 チェレンコフ角・角度分解能

チェレンコフ光の式より、チェレンコフ角 θ_c は、鏡の焦点距離 f とリング半径 r を用いて次のように表せる。

$$\theta_c = \arctan\left(\frac{r}{f}\right) \quad (3.2)$$

この式より、イベントごとのチェレンコフ角 θ_c を計算し、全イベント分を積み上げたヒストグラムをガウスフィットし、mean をその電圧でのチェレンコフ角とした。

図 (Vov5V の時のチェレンコフ角)

チェレンコフ角のヒストグラムをガウスフィットし、mean をその電圧でのチェレンコフ角 θ_c 、分散を角度分解能とした。

第 4 章

結果

4.1 hit 数

全電圧での hit 数をまとめると、図 4.1 の様に $V_{ov}5V$ でサチュレーションしていることがわかる。そこで、このサチュレーションしている hit 数がもっともらしいことを計算により確かめる。チェレンコフ光の発生光子数 N_0 は、次の式で求めることができる。

$$N_0 = 2\pi\alpha L \left(1 - \frac{1}{(n\beta)^2}\right) \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) \quad (4.1)$$

ここで、 α は微細構造定数、 n は輻射体の屈折率、 β は粒子の速度、 L は輻射体の長さ、 λ_1, λ_2 は MPPC の感度のある波長である。ただし、実際に検出される光子数 N_{det} はこの N_0 に鏡の反射効率 ϵ_{mirror} や MPPC の量子効率 ϵ_{MPPC} を用いて次のようにかける。

$$N_{det} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} N_0(\lambda) \epsilon_{mirror}(\lambda) \epsilon_{MPPC}(\lambda) d\lambda \quad (4.2)$$

また、今回は 1 つのセグメントに同時に複数個の光子が入ってきても 1hit と数えることにより数え落としてしまうことがある。式 4.2 より検出光子数を計算し、シミュレーションによって消えてしまう光子数を見積もった。その結果、図 4.2 のように、サチュレーションしているところでは解析値と一致していることがわかった。

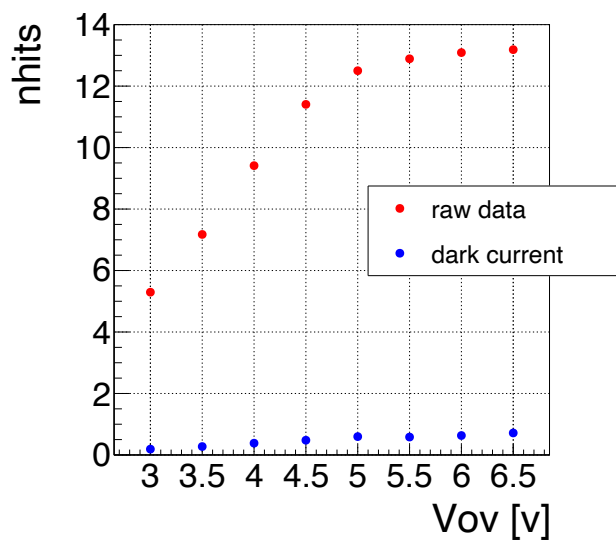


図 4.1 信号と暗電流の hit 数

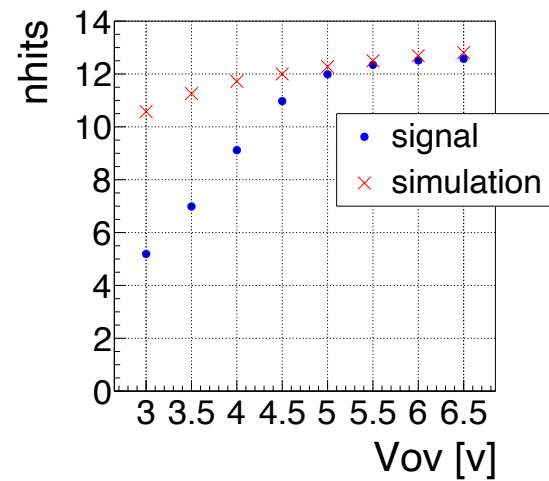


図 4.2 信号と simulation の hit 数

4.2 リング半径・チェレンコフ角

各電圧でのチェレンコフ角とリング半径は図 4.3, 4.4 のようになった。

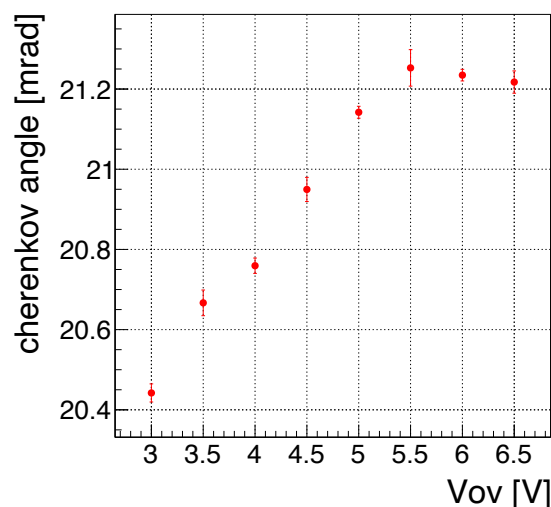


図 4.3 各電圧でのチェレンコフ角

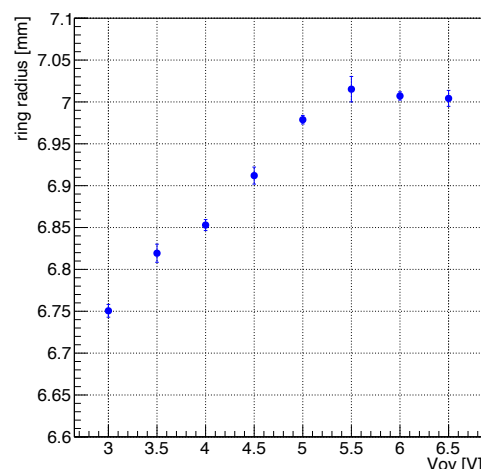


図 4.4 各電圧でのリング半径

4.2.1 リング半径・チェレンコフ角の絶対値のズレ

まず、得られたチェレンコフ角・リング半径の絶対値について考える。ただし、チェレンコフ角とリング半径は式 3.2 より 1 対 1 対応なので、ここではリング半径について考える。MPPC が球面鏡の焦点面に配置されていた場合、MPPC 上でのリング半径 r は球面鏡の焦点距離 $f = 330\text{mm}$ 、チェレンコフ角 θ_c から $r = f \tan \theta_c$ とかけ、計算すると $r = 7.7\text{mm}$ となった。この値は、解析で得られた値より 10% ほど大きい。今回の実験では MPPC の配置が球面鏡の焦点面から 42 mm ほどズレていたため、それが原因ではないかと考えた。図 4.5 のように、MPPC が焦点面からズレていた場合焦点面で収束されるはずの光が内側と外側に広がってしまう。上流側の光が多いほど内側にくる光が多くなる。今回のセットアップによるズレを考慮して計算を行うと表 4.2 のようになった。この平均値が解析で得られる値と考えると、先ほどとは逆に解析値の方が 5% ほど大きくなっている。これは絶対値のズレは暗電流が影響していると考えられる。図 4.6 のように、暗電流がリングの外側に出てしまった場合そのイベントのリング半径は実際よりも大きくなってしまふ。リングの内側に暗電流が発生した場合はリング半径は小さくなるが、今回のリングと MPPC アレイのサイズ関係だと内側よりも外側の方が面積が大きいため、暗電流によってリング半径が大きく見積もられてしまう。

表 4.1 リング半径の広がり (mm)

min	avg	xax
4.54	6.62	8.69

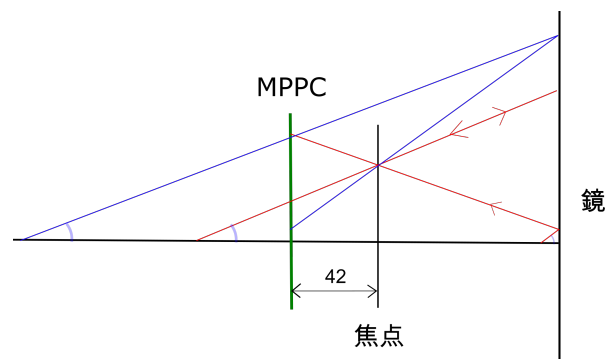


図 4.5 光学系

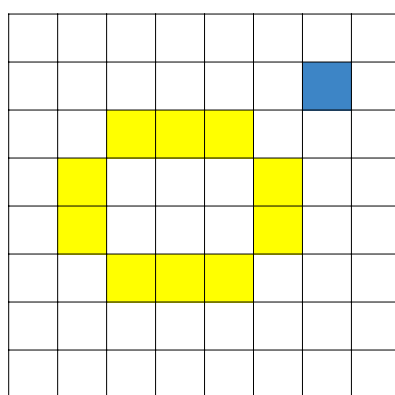


図 4.6 黄：実際に光子が当たったセグメント、青：暗電流による hit があったセグメント

4.2.2 リング半径・チェレンコフ角の電圧依存性

リング半径とチェレンコフ角の電圧依存性を考えるために、簡単なシミュレーションをおこなった。リング中心は (3.3, 3.9)、リング半径は 4.54 ~ 8.69 mm の範囲でランダムに決定。1 イベントごとの発生光子数は 68 個、MPPC の検出確率は各電圧での値を用いた。また、1 セグメントに複数の光子が同時に入る効果やセグメント間の隙間も考慮した。以上の条件で、実際の解析と同様の手順でリング半径を求めた。図 ?? を見ると、シミュレーションでもリング半径に電圧依存性が見られることがわかる。これは暗電流の効果が原因と考えられる。暗電流にはリング半径を大きくする効果があり、電圧を上げていくと暗電流が増加していくので、リング半径・チェレンコフ角が増加していく。

4.3 角度分解能

各電圧での角度分解能をまとめると図 4.8 のようになった。分解能も V_{ov} 5 V あたりでサチュレーションしていることがわかる。

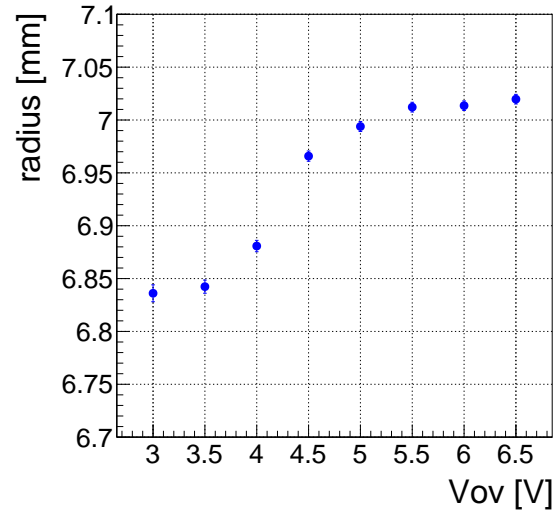


図 4.7 シミュレーションによるリング半径

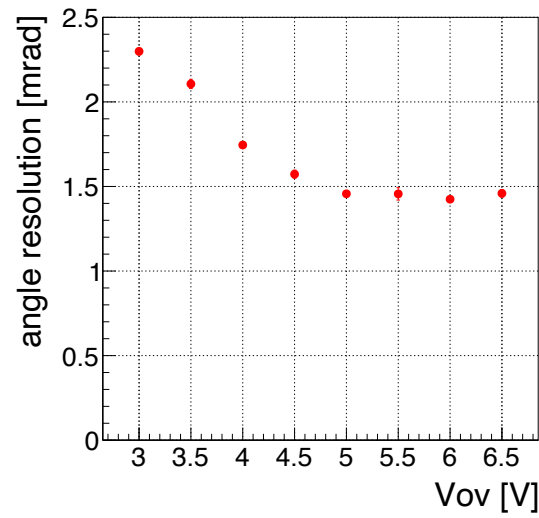


図 4.8 各電圧での角度分解能

4.3.1 1 p.e. あたりの分解能

1 p.e. あたりの分解能を求めるために、イベントごとの hit 数で場合分けをし分解能を求めた。図 4.9 のグラフを 1 p.e. あたりの分解能を $\Delta\theta_{1p.e.}$ として、 $\frac{\Delta\theta_{1p.e.}}{\sqrt{n_{hits}}}$ でフィットした。フィッティングの値より、 $\Delta\theta_{1p.e.} = 4.85 \pm 0.01$ mrad と求められた。

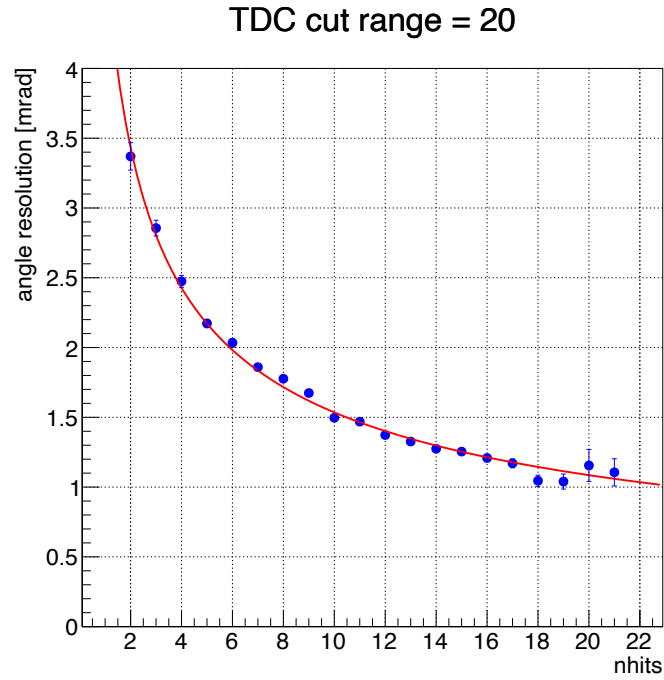


図 4.9 hit 数ごとの分解能

4.3.2 角度分解能の内訳

4.3.3 収差などによる角度分解能

4.3.4 暗電流の角度分解能への寄与

暗電流の角度分解能への影響を調べるために、暗電流がある場合と、暗電流なしの極限 (TDC の cut 幅を 0 にした極限) での角度分解能と 1 p.e. あたりの分解能をそれぞれ調べた。まず、TDC の cut 幅を 100 ch まで 20 ch ずつ広げていき暗電流の割合を増加させた時の分解能を調べることで、暗電流なしの極限での角度分解能を求めた。図 4.10 に外挿して、cut 幅 0 で暗電流なしの極限を見ると $\sim 1.38\text{mrad}$ の分解能を得られる。また、角度分解能と 1 p.e. あたりの分解能の関係式 $\frac{\Delta\theta_{1p.e.}}{\sqrt{nhits}} = \Delta\theta$ より、cut 幅 20 の場合から

$$\begin{aligned}\frac{4.85\text{mrad}}{\sqrt{nhits}} &= 1.45\text{mrad} \\ \sqrt{nhits} &= 3.34\end{aligned}\tag{4.3}$$

が求まる。よって、cut 幅 0 での 1 p.e. あたりの分解能 $\Delta\theta_{1p.e.}$ は $\frac{\Delta\theta_{1p.e.}}{\sqrt{nhits}} = 1.38\text{mrad}$ より $\Delta\theta_{1p.e.} = 4.62\text{mrad}$ となる。

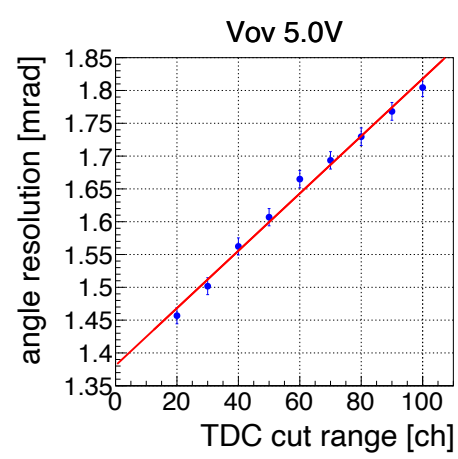


図 4.10 TDC の cut 幅を広げていった時の分解能

第 5 章

まとめ